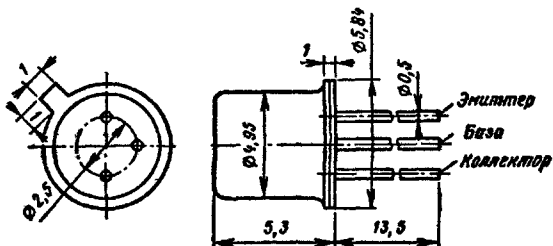


Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные, структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и генераторах сохой и низкой частот, переключающих и импульсных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

## КТ343(А-В)



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КВ}=0,3$ В, $I_B=10$ мА, не менее:	
$T=+25$ и $+85$ °С КТ343А, КТ343В	30
$T=+25$ и $+85$ °С КТ343Б	50
$T=-40$ °С КТ343А, КТ343В	15
$T=-40$ °С КТ343Б	25
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КВ}=5$ В, $I_B=10$ мА, не менее	300 МГц
Время рассасывания при $I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА, не более:	
КТ343А, КТ343В	10 нс
КТ343Б	20 нс
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА, не более	0,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{КВ}=10$ В для КТ343А, КТ343Б и $U_{КВ}=7$ В для КТ343В, не более:	
$T=+25$ °С	1 мкА
$T=+85$ °С	10 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{об}=10$ кОм, $U_{КВ}=U_{КВ, макс.}$ , не более	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭВ}=4$ В, не более	100 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КВ}=5$ В, не более	6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭВ}=0$ , не более	8 пФ
<b>Предельные эксплуатационные данные</b>	
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{об} \leq 10$ кОм:	
КТ343А, КТ343Б	17 В
КТ343В	9 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Максимальный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 500$	150 мА
Одинная рассеиваемая мощность коллектора	
$T \leq +70$ °С	150 мВт
$T = +85$ °С	130 мВт
Температурное сопротивление переход-среда	0,5 °С/мВт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-40 +85 °С